

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 6 部門第 3 区分
 【発行日】平成22年4月8日 (2010.4.8)

【公表番号】特表2009-524152(P2009-524152A)
 【公表日】平成21年6月25日 (2009.6.25)
 【年通号数】公開・登録公報2009-025
 【出願番号】特願2008-551453(P2008-551453)
 【国際特許分類】

G 0 6 F 12/16 (2006.01)
 H 0 3 M 13/29 (2006.01)
 G 1 1 C 16/06 (2006.01)
 H 0 3 M 13/19 (2006.01)
 H 0 3 M 13/11 (2006.01)
 H 0 3 M 13/15 (2006.01)
 H 0 3 M 13/25 (2006.01)

【F I】

G 0 6 F 12/16 3 2 0 F
 H 0 3 M 13/29
 G 1 1 C 17/00 6 3 9 C
 H 0 3 M 13/19
 H 0 3 M 13/11
 H 0 3 M 13/15
 H 0 3 M 13/25

【手続補正書】
 【提出日】平成22年2月16日 (2010.2.16)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0 0 1 0
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【0 0 1 0】

マルチレベル固体不揮発性メモリにおいて隣接するレベル間の電圧分離が減少すると、従来の固体不揮発性メモリセルに比べて誤り数が増加しうる。従って、マルチレベルセルを有する固体不揮発性メモリを動作させる改善された方法及び技術が望ましい。

なお、本出願に対応する外国の特許出願においては下記の文献が発見または提出されている。

【特許文献 1】米国特許第 6 2 7 9 1 3 3 号明細書
 【特許文献 2】米国特許出願公開第 2 0 0 1 / 0 0 2 5 3 5 8 号明細書
 【特許文献 3】米国特許出願公開第 2 0 0 2 / 0 0 3 8 4 4 0 号明細書
 【特許文献 4】米国特許出願公開第 2 0 0 4 / 0 0 4 2 2 9 4 号明細書
 【特許文献 5】米国特許第 7 3 1 0 7 6 8 号明細書
 【特許文献 6】米国特許第 5 4 6 9 4 4 8 号明細書
 【特許文献 7】米国特許第 7 0 4 3 1 6 2 号明細書
 【特許文献 8】米国特許第 7 2 5 9 9 9 7 号明細書
 【特許文献 9】米国特許第 7 3 4 6 8 2 9 号明細書
 【特許文献 10】米国特許第 7 1 4 2 6 1 2 号明細書
 【特許文献 11】米国特許出願公開第 2 0 0 4 / 0 0 6 2 1 1 1 号明細書
 【特許文献 12】米国特許出願公開第 2 0 0 7 / 0 2 0 4 2 0 6 号明細書

【特許文献 13】米国特許出願公開第 2 0 0 4 / 0 0 8 3 3 3 4 号明細書

【特許文献 14】米国特許出願公開第 2 0 0 7 / 0 1 7 1 7 3 0 号明細書

【特許文献 15】米国特許第 6 7 1 5 1 1 6 号明細書

【特許文献 16】米国特許第 6 4 4 2 7 2 6 号明細書

【非特許文献 1】Supplementary European Search Report mailed June 24, 2009, for International Application No. PCT/US2007001623

【非特許文献 2】Examination Report mailed September 28, 2009, for European Patent Application No. 07718319.2

【非特許文献 3】Examination Report mailed September 28, 2009, for European Patent Application No. 07718293.9